

电子科学与工程学院研究生申请学位成果提交要求

一、研究生申请学位，须按照要求提交以下材料：

1、导师审核签字的科研成果清单（格式见附件）；

2、成果证明材料（每个成果最好一页纸，按清单编号顺序排序并**右上角编号**，成果证明文件要求**严格按照**本文最后的评奖评优成果证明材料格式，共同 1 作还需附论文首页，圈出“equally to this work”等文字）；

3、5 月 25 日之前登陆以下链接：<https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/4a06e53b-6a93-40da-809a-bd190a720004/>。

二、成果清单按如下示例格式填写：**（注意每个成果后使用回车键）**

1、论文：

(1) 期刊全名，SCI，1 作，**学科卓越/1 区**，IF3.28，201509 录用，201603 发表；

(2) 期刊全名，SCI，**共同 1 作（按照实际排序列出所有一作作者，例如：张三、李四、王五）**，**学科一流/1 区**，IF3.29，201609 录用，未发表；

(3) 期刊全名/会议全名，**学科重要/EI**，1 作，201401 录用，201404 发表；

(4) 期刊全名，核心，1 作，201212 录用，201301 发表；

(5) 国内会议（会议名），1 作，201211 录用，201301 发表；

(6) 国际会议（会议名），1 作，201211 录用，201301 发表；

2、专利：

(1) 发明专利，2 作/导师 1 作，201402 申请，201601 授权/尚未授权；

(2) 实用新型专利，2 作/导师 1 作，201402 申请，201601 授权/尚未授权；

3、竞赛：

(1) 2019 年中国研究生电子设计竞赛全国一等奖**（按照实际排序列出所有获奖人，例如：张三、李四、王五……）**；

4、其他：

(1) 其他为学院和学科发展做出的突出贡献（需附详细材料说明），……；

(2) 参与重大国家科研项目并作出突出贡献（需附详细材料说明），……

(3) 1……

【注意】：

1、**分区和影响因子需按照如下方式查找填写**：示例中**学科卓越/1 区**，1 区为中信所分区（南大科技处网站—科技成果-科技论文，选**最新年度分区表**

<https://scit.nju.edu.cn/10973/list.htm>) ; 学科卓越为网上办事大厅搜索“高质量科技期刊与学术会议目录”平台(仅教职工有权限,请导师或课题组秘书帮忙查询)点击立即办理搜索所得分区,若未检索到可在附件《电子科学与工程学院高质量科技期刊与学术会议目录》检索。如两个都有分区,必须都写上,不得只写一个;

2、共同 1 作需附论文首页,圈出“equally to this work”文字;

3、成果第一署名单位需为南京大学。

三、成果证明材料格式

1、SCI 文章

(1) 已发表文章要提供南大图书馆 ISIWebofKnowledge (选择数据库为“WebofScienceTM 核心合集”)检索截图,并按照示例格式圈出重要信息,第一作者和通信作者单位都应是南京大学;无法检索的,复印论文首页,其上写明为何不能检索理由,并请导师手写签署如下意见“该论文已发表,将被 SCI 收录”并签名;

(2) 录用的文章必须是收到正式录用通知才能被认可(修改等均不认可),需提供论文首页和录用函,并请导师手写签署如下意见“该论文已录用,将被 SCI 收录”并签名。录用函中要圈出期刊名称、文章名称、“accepted”关键字;论文首页要圈出作者、单位等关键字;

(3) 分区和影响因子截图按照文末示例格式。

2、EI 文章(只接受全文收录)

(1) 已发表文章提供南大图书馆 EI-EngineeringVillage2 工程索引检索截图,并按照示例格式圈出重要信息;无法检索的,复印论文首页,其上写明为何不能检索理由,并请导师手写签署如下意见“该论文已发表,将被 EI 收录”并签名;

(2) 录用的文章必须是收到正式录用通知才能被认可,需提供论文首页和录用函,并请导师手写签署如下意见“该论文已录用,将被 EI 收录”并签名。录用函中要圈出期刊名称、文章名称、“已录用”关键字、录用函日期;论文首页要圈出作者、单位等关键字;

(3) 分区截图按照文末示例格式。

3、专利

(1) 必须提供中国专利查询系统检索截图,并按照示例格式圈出重要信息;

(2) 无法检索的,复印带有本人姓名和专利申请号的专利申请单,其上写明为何不能检索理由,并请导师签名;

(3) 授权专利提供专利授权证书复印件。

4、中文核心等其他成果提供论文（或录用函）首页或其他证明文件，圈出姓名、学校、日期等关键字，请导师签字。

附：专利、EI、SCI 检索示例。**打印后红笔圈出关键字**，比较醒目，方便核查。


专利：

发明 [一种基于变焦视频序列的图像超分辨率重建方法-申请号/专利号：2012105521716](#)

申请人：南京大学

申请日：2012-12-19

主分类号：G06T 5/00

 [基本信息](#) - [审查信息](#) [添加评论](#)

必须要圈出发明或实用新型等关键字。

申请信息	审查信息	费用信息	发文信息	布告公告	专利登记簿	同族案件信息
著录项目信息						
申请号/专利号：2012105521716 申请日：2012-12-19 案件状态：专利权维持			发明名称：一种基于变焦视频序列的图像超分辨率重建方法 主分类号：G06T 5/00 分案提交日：			
申请人						
姓名或名称	国籍或总部所在地	邮政编码	详细地址			
南京大学	--	--	--			
发明人/设计人						
发明人姓名：袁杰、 封婷 、温馨、邵真天、朱毅、李文超、张星、都思丹						

申请信息	审查信息	费用信息	发文信息	布告公告	专利登记簿	同族案件信息
发明公布/授权公告						
<input type="checkbox"/>	公告（公布）号	公告类型	卷期号	公告（公布）日	操作	
<input type="checkbox"/>	CN 103034982 A	发明公布	29-15	2013-04-10		
<input type="checkbox"/>	CN 103034982 B	发明授权公告	31-27	2015-07-08		
事务公告						
	事务公告类型	公告卷期号	事务公告日			
	实质审查请求生效	29-19	2013-05-08			

EI:

[Abstract](#)
[Detailed](#)

Record 1 from Compendex for: ((Study of dislocation densities of thick GaN films) WN All fields), 1969-2015

Check record to add to Selected Records

1. **Accession number:** 20143418082911
Title: Study of dislocation densities of thick GaN films
Authors: Li, Yon Gan¹; Xiu, Xiang Qian¹; Hua, Xue Mei¹; Zhang, Shi Ying¹; Gu, Shi Pu¹; Zhang, Rong¹; Bin¹; Chen, Peng¹; Han, Ping¹; Zheng, You Dou¹
Author affiliation: ¹ Division of Microelectronics, School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University, Nanjing, 210093,
Source title: Advanced Materials Research
Abbreviated source title: Adv. Mater. Res.
Volume: 989-994
Monograph title: Materials Science, Computer and Information Technology
Issue date: 2014
Publication year: 2014
Pages: 387-390
Language: English
ISSN: 10226680
E-ISSN: 16628985
ISBN-13: 9783038351733
Document type: Conference article (CA)
Conference name: 4th International Conference on Materials Science and Information Technology, MSIT 2014
Conference date: June 14, 2014 June 15, 2014
Conference location: Tianjin, China
Conference code: 106909
Sponsor: Computer Science and Electronic Technology; Inst. of Mechatronics Eng., Tianjin Univ. of Technol. and Educ.; Tr

(若会议属于综合顶级/学科卓越/学科一流/学科重要分区, 请补充截图(参照如下 SCI 分区截图))

SCI 分区和影响因子截图按照如下格式：

1、综合顶级/学科卓越/学科一流/学科重要分区截图



(若以上系统中未检索到可在附件《电子科学与工程学院高质量科技期刊与学术会议目录》

检索“参照学科重要”分区截图 (请将第一列编号也截图)

1	名称	分类
44	IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY	参照学科重要

2、中信所分区截图



(请将第一列编号也截图)

3、SCI 截图：

WEB OF SCIENCE™

返回检索

全文选项 | 保存至 EndNote Online | 添加到标记结果列表

Indium-rich InGaN epitaxial layers grown pseudomorphically on a nano-sculpted InGaN template

作者: Xue, JJ (Xue, J. J.)^[1]; Chen, DJ (Chen, D. J.)^[1]; Liu, B (Liu, B.)^[1]; Lu, H (Lu, H.)^[1]; Zhang, R (Zhang, R.)^[1]; Zheng, YD (Zheng, Y. D.)^[1]; Cui, B (Cui, B.)^[2]; Wowchak, AM (Wowchak, Andrew M.)^[2]; Dabiran, AM (Dabiran, Amir M.)^[2]; Xu, K (Xu, K.)^[3]; Zhang, JP (Zhang, J. P.)^[3] 更多内容

OPTICS EXPRESS
 卷: 20 期: 7 页: 8093-8099
 DOI: 10.1364/OE.20.008093
出版年: MAR 26 2012
[查看期刊信息](#)

摘要
 Indium-rich InGaN epitaxial layers with a p-i-n structure were grown pseudomorphically on a strain-relaxed InGaN template to reduce structural strain induced by lattice mismatch. We applied a nano-sculpting process to improve the crystal quality of the strain-relaxed InGaN template. The results show that the nano-sculpting process can suppress effectively the threading dislocation generation and improves significantly the I-V characteristic of the InGaN p-i-n structure. This InGaN template technique with nano-sculpting process shows great potential for future applications in indium-rich InGaN optic-electron devices. (C) 2012 Optical Society of America

关键词
 KeyWords Plus: DIFFRACTION DATA; INN; GAN; HETEROSTRUCTURE; DIODES; STRAIN

作者信息
 通讯作者地址: Xue, JJ (通讯作者)
 + Nanjing Univ, Key Lab Adv Photon & Elect Mat, Nanjing Natl Lab Microstruct, Sch Elect Sci & Engr, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China.
 地址:
 + [1] Nanjing Univ, Key Lab Adv Photon & Elect Mat, Nanjing Natl Lab Microstruct, Sch Elect Sci & Engr, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China
 [2] SVT Associates Inc, Eden Prairie, MN 55344 USA
 + [3] Chinese Acad Sci, Suzhou Inst Nanotech & Nanobion, Suzhou 215125, Peoples R China

